

付

## 特許・実用新案登録一覽

—1989年度—

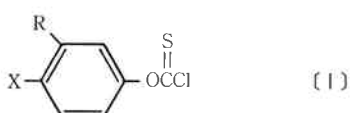
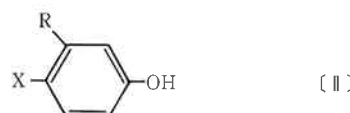
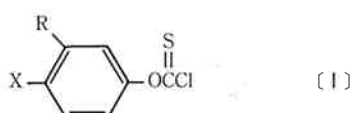
〈日本特許〉 57件

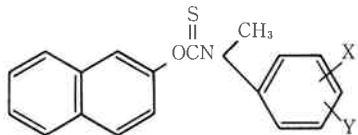
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
1	56-004142 S56.01.14 (高木 弘義, 鈴木 一 西岡 憲一) (工業技術院長, 日本化学 陶業株式会社と共願)	63-017768 S63.04.15	01474118 H01.01.18	M <sup>II</sup> O-M <sub>2</sub> M <sup>III</sup> O <sub>3</sub> 系粉体の製造方法	<p>1 M<sup>II</sup>O-M<sub>2</sub>M<sup>III</sup>O<sub>3</sub>系粉体の製造方法において、水溶性 M<sup>II</sup> 塩 (但し、M<sup>II</sup> は Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Ba<sup>2+</sup> から選ばれる少なくとも一種の金属イオン) と、水溶性 M<sup>III</sup> 塩 (但し、M<sup>III</sup> は Al<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup> から選ばれる少なくとも一種の金属イオン) の混合溶液に有機溶剤を加え、アンモニアアルカリ性の沈殿剤を加えた後、得られる沈殿物を分離、乾燥の後、熱分解することを特徴とする M<sup>II</sup>O-M<sub>2</sub>M<sup>III</sup>O<sub>3</sub>系酸化物粉体の製造方法。</p> <p>2 M<sup>II</sup>O-M<sub>2</sub>M<sup>III</sup>O<sub>3</sub>系粉体の製造方法において、水溶性 M<sup>II</sup> 塩 (但し、M<sup>II</sup> は Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Ba<sup>2+</sup> から選ばれる少なくとも一種の金属イオン) と、水溶性 M<sup>III</sup> 塩 (但し、M<sup>III</sup> は Al<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup> から選ばれる少なくとも一種の金属イオン) の混合溶液にアンモニア水を加え、更に有機溶剤を加えた後、アンモニアアルカリ性の沈殿剤を加え、得られる沈殿物を分離、乾燥の後、熱分解することを特徴とする M<sup>II</sup>O-M<sub>2</sub>M<sup>III</sup>O<sub>3</sub>系酸化物粉体の製造方法。</p>
2	53-119123 S53.09.29 (斉藤 寿広, 荒井 昭治 堤 幸弘)	62-054781 S62.11.17	01477255 H01.01.27	ヒドロキシブチルアルデヒド類の製造方法	<p>1 有機三置換ホスフィンを配位子とするロジウム錯体触媒の存在下で、反応溶媒中で、アリールアルコールを一酸化炭素および水素と反応させ、ヒドロキシブチルアルデヒド類を製造する方法において、それぞれ 200°C 以上の沸点を有する有機三置換ホスフィンおよび反応溶媒を用い、かつ該ホスフィン濃度を該溶媒 1ℓ 中、5×10<sup>-4</sup> mol~0.3 mol で反応を行った後、酸素不存下に、80°C 以下で反応液の減圧蒸溜を行い、該錯体触媒の該溶媒溶液と反応生成物を分離することを特徴とするヒドロキシブチルアルデヒド類の製造方法。</p>
3	54-026737 S54.03.09 (森下 悟, 小坂勇次郎)	63-022850 S63.05.13	01477267 H01.01.27	希薄重水素を含む水素ガスから重水素を濃縮する方法	<p>1 希薄重水素を含む水素ガス中の重水素を濃縮する方法に於て、あらかじめ加熱処理したナトリウムA型ゼオライト成形体をナトリウムイオン含有水溶液と接触させてえられたゼオライト成形体に、上記水素ガスを接触させて重水素を該ゼオライト成形体に吸着させ、次いで、該ゼオライト成形体から重水素を分離する事を特徴とする重水素の濃縮方法。</p>
4	54-104954 S54.08.20 (青木 哲也, 岡田 宏亮)	63-020489 S63.04.27	01477276 H01.01.27	点滴形灌水パイプを製造する方法	<p>1 同種又は異種の二枚の熱可塑性樹脂の帯状フィルムを重ね合せ、表面に下記の導管部と流路模様のパターンを凹部として有する熱ロールとプレスロールで挟み、該熱ロールの凸部とプレスロールで該二枚のフィルムを熱融着させることにより、長手中央部に導管部を、そしてこの導管部の両長手側面にひれ状に突き出た積層接合部を、この接合部の少なくとも一方に導管部から枝分かれしかつ絞り部の線巾/帯模様から流路模様への入口の線巾(絞り率)が0.7~</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					0.1の絞り部を入口の近傍に有する流路模様の散水流路を有する点滴形灌水パイプを製造する方法。
5	57-129653 S 57.07.27 (村上河本)	63-020782 S 63.04.30 (次雄, 平賀泰三)	01477347 H01.01.27 要一	生石灰から高品位水酸化カルシウムを製造する方法	1 生石灰を水和させて水酸化カルシウムを製造する方法において、生石灰を乳化率30~80%で乳化した後、固形分を分級して水酸化カルシウムの乳化物を得ることを特徴とする生石灰から高品位水酸化カルシウムを製造する方法。
6	57-162122 S 57.09.20 (増田良道)	63-030978 S 63.06.21 (良道, 渡辺龍三)	01481460 H01.02.10 龍三	金属クロムの活性焼結法	1 金属クロム微粉に水溶性パラジウム塩水溶液を含浸させ、乾燥した後、100~400 Mpa (10~40 kg/mm <sup>2</sup> ) で圧粉し、これを 700~900°C で一次焼結し、更に 1000~1400°C で二次焼結することを特徴とする金属クロムの活性焼結法。
7	57-092196 S 57.06.01 (毛利)	62-061675 S 62.12.22 (隆, 吉田節夫)	01482689 H01.02.27	電極の製造法	1 クロム、ニッケル又はこれらを含む合金相を表面組成として持つ金属基体表面に、アンモニウムイオンを含み、かつ pH 2.5 以下のニッケルメッキ浴を用いてニッケルメッキを施し、次いで硫黄を含むニッケルメッキ浴を用いてニッケルメッキを施すことを特徴とする電極の製造法。 2 クロム、ニッケル又はこれらを含む合金相に表面組成として持つ金属基体表面に、pH 1 以下の塩酸性ニッケル浴を用いて第一の下地にニッケルメッキを行い、さらにその上にアンモニウムイオンを含むニッケルメッキ浴を用いて第二の下地ニッケルメッキを施した後、硫黄を含むニッケルメッキ浴を用いてニッケルメッキを施すことを特徴とする電極の製造法。
8	56-183039 S 56.11.17 (長田月館)	63-035563 S 63.07.15 (真司, 笠井隆明)	01488617 H01.03.23 清	窒化珪素粉末の製造法	1 金属珪素を含む窒素シラン化合物の存在下に 1450°C 以上で窒化性ガスと接触させることを特徴とする窒化珪素粉末の製造法。
9	57-122922 S 57.07.16 (鳴井中川)	63-035161 S 63.07.13 (衛, 米岡辰司, 坂中靖弘)	01488638 H01.03.23 実	クロロスルホン化ポリエチレンの製造法	1 ポリエチレンを塩素と塩化スリフリルを用いてクロロスルホン化し、クロロスルホン化ポリエチレンを製造するに当り、塩化スリフリルでクロロスルホン化する工程と塩素により塩素化する各々の工程からなり、各工程を 85°C~150°C で行ない、所要とする塩素含量の30~90%相当量を塩化スリフリルで行ない、10~70%相当量を塩素で行うことを特徴とするクロロスルホン化ポリエチレンの製造法。
10	57-122923 S 57.07.16 (鳴井坂中)	63-035162 S 63.07.13 (衛, 中川靖弘)	01488639 H01.03.23 辰司	クロロスルホン化ポリエチレンの製法	1 ポリエチレンをハロゲン化溶剤に溶解したのち塩素で塩素化し、次いで 50~100°C の温度で塩化スリフリルでのクロロスルホン化反応を実質上完結させたのち、さらに塩素を導入して反応せしめることを特徴とするクロロスルホン化ポリエチレンの製法。
11	56-150651 S 56.09.25 (久保藤村)	63-040409 S 63.08.11 (雅滋, 堤幸弘, 藤村俊一, 福田暉夫)	01489522 H01.03.23 幸弘	塩化ビニルモノマーを選択的に吸着回収する方法	1 低沸点成分を含む塩化ビニルモノマーを複数の吸着床に直列に導入して塩化ビニルモノマーを導入方向前段の吸着床に吸着させ、塩化ビニルモノマー破過帯の移行を低沸点成分及び/又は塩化ビニルモノマーの吸着熱に起因する局部的温度上昇によって検出し、該破過帯が前

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
12	61-224356 S 61.09.22 (近藤 陽三, 大橋 要 細井 吉弘) (古河電気工業(株)と共願)	63-037146 S 63.07.22	01487486 H01.03.23	耐放射線性高分子組成物	<p>段吸着床より後段吸着床へ移行した時点で上記低沸点成分を含む塩化ビニルモノマーの導入を前段吸着床から後段吸着床に切換えて後段吸着床を次工程の前段吸着床として塩化ビニルモノマーを吸着させ、又他方前記の導入を止めた前段吸着床はその吸着剤を加熱して塩化ビニルモノマーを真空減圧下に脱着回収することを特徴とする塩化ビニルモノマーを選択的に吸着回収する方法。</p> <p>1 高分子重合体に下記一般式〔I〕</p> <div data-bbox="943 640 1401 846" style="text-align: center;"> <p style="text-align: right;">(I)</p> </div> <p>(式〔I〕中、Xは塩素または臭素、aは0~2、bは1~6、nは1以上の整数を表わす) で示されるハロゲン化アセナフチレンおよび/またはその縮合体と、下記一般式〔II〕</p> <div data-bbox="943 987 1401 1088" style="text-align: center;"> <p style="text-align: right;">(II)</p> </div> <p>(式〔II〕中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> は水素、アルキル、アルコキシ、フェニル、フェノキシ、ジフェニルオキシ、ターフェニルオキシ基の何れかを表わす) で示されるジフェニルエーテル誘導体とを配合したことを特徴とする耐放射線性高分子組成物。</p>
13	54-124203 S 54.09.28 (上野 喜美, 村山 浩)	63-038375 S 63.07.29	01491590 H01.04.07	高濃度顔料分散体の製造法	<p>1 湿潤顔料ケーキとビクルとを混練し遊離水を除去した後、これに芳香族炭化水素と低級アルコールとを添加混合し、次いで加温しながら減圧下に残存する水と添加した芳香族炭化水素と低級アルコールとを除去することを特徴とする高濃度顔料分散体の製造法。</p>
14	56-067611 S 56.05.07 (松井 清英, 朱山 秀雄 飛田 悦子, 川崎 信弘 小林 宜男, 斎藤 光高 近藤 聖) (相模中央化学研究所と共願)	63-036343 S 63.07.20	01491634 H01.04.07	フルオロカーボン重合体の溶液	<p>1 スルホニル基含有フルオロカーボン重合体の1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン溶液。</p>
15	58-073859 S 58.04.28 (藤本 輝雄, 宮木 義行 福田 三寿)	63-036602 S 63.07.21	01491663 H01.04.07	フェノール残基を有する狭分散高分子の製造方法	<p>1 有機金属化合物からなるリビングアニオン重合開始剤を用いてフェノール残基の水酸基が飽和脂肪族系保護基により保護された下記一般式で示されるモノマー</p> <div data-bbox="1034 1827 1318 1928" style="text-align: center;"> </div> <p>(但し、式中 R<sub>1</sub> は水素又は炭素数1~12のアルキル基、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub> は各々炭素数1~12のアルキル基、R<sub>4</sub> は水素又はメチル基を示す。) を単独重合あるいはこれと共重合可能なモノ</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					マーとブロック共重合した後、飽和脂肪族系保護基を脱離させることを特徴とするフェノール残基を有する狭分散高分子の製造方法。
16	56-173086 S 56.10.30 (長田 眞司, 笠井 清 月館 隆明)	63-043360 S 63.08.30	01494227 H01.04.20	繊維状窒化珪素の製造方法	1 含窒素シラン化合物を、80容量%以上の水素を含み、窒素含有量が0~10容量%である雰囲気下で、1300°C~1400°C で1時間以上加熱分解することを特徴とする繊維状窒化珪素の製造方法。
17	57-233997 S 57.12.31 (石川 延男, 高橋 満) (ダイキン工業(株)と共願)	63-045655 S 63.09.12	01494630 H01.04.20	ペルフルオロ又はポリフルオロ脂肪族カルボン酸の製造方法	1 一般式： RfX (但し、Rf はペルフルオロ又はポリフルオロ脂肪族基、Xはハロゲンを示す。)で表わされるペルフルオロ又はポリフルオロ脂肪族ハロゲン化物と二酸化炭素とを、亜鉛の存在下にて超音波の作用下で反応させ、この反応生成物を加水分解することによって、 一般式： RfCOOH (但し、Rf は前記したものと同一である。)で表わされるペルフルオロ又はポリフルオロ脂肪族カルボン酸を生成させることを特徴とするペルフルオロ又はポリフルオロ脂肪族カルボン酸の製造方法。
18	58-041550 S 58.03.15 (榊 孝, 杉森 正敏 伊原 義尚)	63-042714 S 63.08.25	01494249 H01.04.20	塩化アルカリ電解槽の防食方法	1 金属性の単位電解槽を複数個電気的に直列接続して構成され、各単位電解槽本体には電気絶縁性の陰極室液供給管および陰極室生成液抜出管が設けられ、該陰極室液供給管および/または該陰極室生成液抜出管には共通の通路を通じて供給液および/または抽出液を集める様にして構成される電解槽プラントにおいて、該陰極室液供給管内、該陰極室生成液抜出管内、共通の通路内のいずれか少なくとも1箇所に補助電極を設け、補助電極にかかる電圧が複極式電解装置のアノード端子電圧より 0.1 V 以上高くすることを特徴とする塩化アルカリ電解槽の防食方法。
19	57-176078 S 57.10.08 (板橋 有家 潤二)	63-046006 S 63.09.13	01498935 H01.05.29	新規なゼオライト及びその合成方法	1 酸化物のモル比で表わし下記の組成： $xM^2/nO \cdot Al_2O_3 \cdot (5 \sim 10)SiO_2 \cdot yH_2O$ (Mは原子価nのカチオンを示し、x, y は係数を有し、かつ第一表に示すX線粉末回折パターンを有し、350°C よりも高い温度で焼成処理することなしにシクロヘキサン 1 wt% 以上(測定条件：25°C, 48 mmHg)吸着できる、ゼオライト。 2 シリカ源、アルミナ源、アルカリ源、ナトリウム源、カリウム源及び水とから成り、モル比で表わし次の条件 $SiO_2/Al_2O_3 = 6 \sim 40$ $OH/SiO_2 = 0.3 \sim 1$ $K/K+Na = 0.1 \sim 0.9$ $H_2O/SiO_2 = 10 \sim 70$ を満足する組成の反応混合物を、攪拌下 120~200°C で結晶化することを特徴とする、第一表に示すX線粉末回折パターンを有するゼオライトの製法。

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
20	57-182698 S 57. 10. 20 (有家 板橋)	63-046007 S 63. 09. 13 潤二, 宮崎 慶治, 相本	01498936 H01. 05. 29 弘 道行)	モルデナイト型ゼオライトの製造方法	1 アルミニウムを $Al_2O_3$ として 3~14 wt% (無水換算) 含む粒状無定形アルミノ珪酸塩均一相化合物を水酸化アルカリ金属水溶液中で結晶化することを特徴とするモルデナイト型ゼオライトの製造方法。
21	58-040610 S 58. 03. 14 (続木 魚谷)	63-047704 S 63. 09. 26 建治, 中西 武)	01499844 H01. 05. 29 明	O-3-tert-ブチルフェニルクロロチオホルメイト及びその製造法	1 O-3-tert-ブチルフェニルクロロチオホルメイト。 2 3-tert-ブチルフェノールとチオホスゲンとを反応させることを特徴とするO-3-tert-ブチルフェニルクロロチオホルメイトの製造法。
22	58-118123 S 58. 07. 01 (続木 橋浜)	63-044748 S 63. 09. 06 建治, 魚谷 充幸)	01498946 H01. 05. 29 武	2-ハロ-6-メチルアミノピリジンの製造法	1 2,6-ジハロピリジンとメチルアミンを脱ハロゲン化水素試剤存在下反応させることを特徴とする2-ハロ-6-メチルアミノピリジンの製造法。
23	58-168428 S 58. 09. 14 (続木 魚谷)	63-047705 S 63. 09. 26 建治, 橋浜 武)	01499846 H01. 05. 29 充幸	3-tert-ブチルフェニルクロロチオホルメイトの製造法	1 3-tert-ブチルフェノールとそれの1.05倍モル以上のチオホスゲンを脱ハロゲン化水素試剤の存在下に反応させることを特徴とする3-tert-ブチルフェニルクロロチオホルメイトの製造法。
24	58-237199 S 58. 12. 17 (森中 野中)	63-047706 S 63. 09. 26 秀夫, 中西 悠次)	01499849 H01. 05. 29 明	クロロチオホルメート誘導体	1 一般式 (I)  (I) (式中Rは炭素数2以上の低級アルキル基を示し, Xはハロゲン原子を示す。)で表わされるクロロチオホルメート誘導体。 2 一般式 (II)  (II) (式中Rは炭素数2以上の低級アルキル基を示し, Xはハロゲン原子を示す。)で表わされるフェノール誘導体とチオホスゲンとを反応させることを特徴とする一般式 (I)  (I) (式中Rは炭素数2以上の低級アルキル基を示し, Xはハロゲン原子を示す。)で表わされるクロロチオホルメート誘導体の製造法。
25	56-059407 S 56. 04. 20 (馬場)	63-053508 S 63. 10. 24 信行)	01505151 H01. 07. 13	液体クロマトグラフの定量送液方法および装置	1 2個の液体クロマトグラフ用シリンジ型ポンプを併設し, 該シリンジ型ポンプの第1のポンプと第2のポンプの各吸引口同志, 各吐出口同志をそれぞれのポンプに同期したチェック弁を介して連結し, かつ前記両ポンプは等速度円板カムとステッピングモータの組合せによりシリンジが往復運動する機構を各々独自に有し, 該両ポンプを駆動して吐出送液するとき, 第1

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>のポンプの吸引工程時間を、該第1のポンプのステッピングモータの回転数を上げることにより早くし、かつこれと平行してその期間のみ、第2のポンプの吐出工程にある等速度円板カムの回転を、第2のポンプのステッピングモータの回転数を上げて早くすることにより脈動の発生を除去することを特徴とする、液体クロマトグラフの定量送液方法。</p> <p>2 2個の液体クロマトグラフ用シリンジ型ポンプを併設し、該シリンジ型ポンプの第1のポンプと第2のポンプの各吸引口同志、各吐出口同志をそれぞれのポンプに同期したチェック弁を介して連結し、かつ前記両ポンプは等速度円板カムとステッピングモータの組合せによりシリンジが往復運動する機構を各々独自に有し、該両ポンプを駆動して吐出送液するとき、第1のポンプの吸引工程時間を、該第1のポンプのステッピングモータの回転数を上げることにより早くし、かつこれと平行してその期間のみ、第2のポンプの吐出工程にある等速度円板カムの回転を、第2のポンプのステッピングモータの回転数を上げて早くする機構とを有することにより脈動の発生を除去するように構成したことを特徴とする、液体クロマトグラフの定量送液装置。</p>
26	57-004829 S 57.01.18 (中谷)	63-054641 S 63.10.28 正樹, 平賀	01506562 H01.07.13 要一)	湿式リン酸から有機物を除く方法	<p>1 未焼成フロリダリン鉱石を硫酸で分解して得た湿式リン酸を、鉄、錫；次亜リン酸およびその塩；ならびにヒドラジンおよびその塩からなる還元物質のうちの1種以上と接触させたのち、さらに活性炭と接触させることを特徴とする上記湿式リン酸から有機物を除く方法。</p>
27	57-154596 S 57.09.07 (竹松 森中 中西)	63-056201 S 63.11.07 哲夫, 近内 秀夫, 野中 明)	01506574 H01.07.13 誠登 悠次	ナフチルチオカーバメート誘導体を含む除草剤	<p>1 一般式</p>  <p>(式中、X及びYは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基又はトリフルオルメチル基を示す。) で表わされるナフチルチオカーバメート誘導体を含む除草剤。</p>
28	55-139567 S 55.10.06 (林 松本 (理化学研究所と共願)	63-060863 S 63.11.25 秀知佳, 和田 勝也, 橋本 勉)	01507815 H01.07.26 昭允 勉)	希釈サンプリング方法	<p>1 酵素反応における反応溶液成分を希釈サンプリングする方法において、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 反応槽からの反応液を一定量保持させるため、サンプリングバルブのサンプリンググループに反応液を絶えず循環し、</li> <li>② 該サンプリングバルブを切換えることにより、サンプリンググループ内に保持された反応液をラインフィルター、攪拌機、複数の流路切換バルブおよび送液ポンプ等からなる密閉流路内で希釈溶液により均一に希釈し、</li> <li>③ 液体クロマトグラフ装置に供給し、</li> <li>④ 該複数の切換バルブを切換えて、洗浄液容器からの流路を該密閉流路の一点に接続し、廃液口を該密閉流路の一点に接続し、そ</li> </ol>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>れによって該密閉流路内を洗浄液で洗浄し、次に該複数の切換バルブを切換えて、希釈溶液容器からの流路を該密閉流路の一点に接続し、廃液口を該密閉流路の一点に接続し、それによって該密閉流路内を希釈溶液で置換することを特徴とする希釈サンプリング方法。</p> <p>2 反応槽に接続されたサンプリングバルブ、液体クロマトグラフ装置に接続されたサンプリングバルブ、複数の流路切換バルブ、攪拌容器、送液ポンプ、ラインフィルター、配管等により構成される密閉流路を具備し、前記反応槽に接続されたサンプリングバルブの切換えて該反応槽と該サンプリングバルブ間を送液ポンプにより絶えず循環している反応溶液から該切換の瞬間にサンプリンググループ内に保持されていた部分をサンプリングし、該サンプルを密閉流路内で希釈溶液で均一に希釈した後、液体クロマトグラフ装置に接続されたサンプリングバルブの切換えにより、一定量の希釈サンプル溶液を液体クロマトグラフ装置に供給し、さらに該複数の切換バルブを切換えて、洗浄溶液容器からの流路を該密閉流路の一点に接続し、廃液口を該密閉流路の一点に接続し、それによって該密閉流路内を洗浄液で洗浄し、次に該複数の切換バルブを切換えて、希釈溶液容器からの流路を該密閉流路の一点に接続し、廃液口を該密閉流路の一点に接続し、それによって該密閉流路内を希釈溶液で置換することを特徴とする希釈サンプリング方法。</p>
29	56-125962 S 56.08.13	63-058171 S 56.11.15	01511849 H01.08.09	成形された高分子材料の表面処理方法 (大野省太郎, 小山 憲治)	1 予め成形された、負電荷を表面に持つ高分子材料を分子量が $10^3$ 以上のポリエチレンオキサイドと分子量が $10^3$ 以上の正電荷を持つ水溶性高分子とが直鎖状に連結されたブロック共重合体の水溶液中に浸漬する事を特徴とする、成形された高分子材料の表面処理方法。
30	57-070483 S 57.04.28	63-060894 S 63.11.25	01511876 H01.08.09	放射線感応性レジスト材を用いる微細加工法 (福田 三寿, 小暮 攻 福富 誠, 三好 一功) (日本電信電話(株)と共願)	1 基板の上に放射線感応性レジスト材の薄膜を形成した後、放射線を照射し、現像、エッチングすることからなる微細加工法において、上記レジスト材がビニルトルエン重合体の電解ハロゲン化反応を行うことにより得られる重合体であることを特徴とする放射線感応性レジスト材を用いる微細加工法。
31	55-043603 S 55.04.04	63-056943 S 63.11.09	01513175 H01.08.24	液体試料中の電解質の測定方法 (仁平 寛久, 清水 洋二)	1 アンモニア又はアンモニウムイオンを含有する液体試料中の2種以上の電解質を同時に測定するにあたり、該液体試料と組成を同じくする液に浸漬した少なくとも塩素電極を含む2種以上のイオン電極を用い、かつ該液体試料中に炭酸ガスを供給することを特徴とする液体試料中の電解質の測定方法。
32	56-173701 S 56.10.31	63-063563 S 63.12.07	01514909 H01.08.24	エチレン重合体又は共重合体の製造法 (太田 音三, 入住 彰 岩野 博文)	1 エチレン又はエチレン及びエチレンと共重合し得る共単量体を含む混合物を管式反応器の入口に導入し、該反応器の長さ方向に沿って、少なくとも一点に重合開始剤を注入して反応圧力 $1000\sim 4000 \text{ kg/cm}^2$ 、反応温度 $120\sim 350^\circ\text{C}$ で重合させて、エチレン重合体又は共重合体を得る方法において、重合開始剤の導入管の途中に重合開始剤制御弁を設け、該反応器出口に設

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					けた出口弁を開にする時刻から反応圧力の低下が該重合開始剤注入点に波及する時刻の後に重合開始剤制御弁を任意開度に強制的に開け、重合開始剤注入点の反応器内圧力が最低点に達する時刻の後に重合開始剤制御弁を任意開度に閉とし、引き続き該圧力が正常値に回復する時刻を経過した後に重合開始剤制御弁を元の開度まで開けることにより、該反応器内壁へのエチレン重合体又は共重合体の付着を防ぐために行なう反応器出口弁の開閉による圧力脈動によって生じる該反応器中のエチレン又はエチレンと共重合し得る共単量体混合物の質量流量の変化に応じた重合開始剤を該反応器を注入することを特徴とするエチレン重合体又は共重合体の製造法。
33	57-129654 S 57. 07. 27 (村上 河本)	63-063486 S 63. 12. 07 次雄, 平賀 泰三)	01514918 H01. 08. 24 要一	高純度塩化カルシウム水溶液の製造方法	1 不純物を含む塩化カルシウムと、水酸化カルシウムおよび/または酸化カルシウムとから水溶液中でオキシ塩化カルシウムを晶出させた後、該水溶液から、得られたオキシ塩化カルシウムを分離し、次いでこれを水の存在下で分解し、溶液中の固相分を除去することを特徴とする高純度塩化カルシウム水溶液の製造方法。
34	57-164061 S 57. 09. 22 (国広 兼重)	63-004771 S 63. 01. 30 信之, 藤本 洋右)	01513228 H01. 08. 24 省三	両面つや消しフィルムまたはシートの製造方法	1 押出機より熔融押出された熱可塑性樹脂製フィルムまたはシートを、ゴムまたは充填剤を配合したゴムを被覆してなる冷却ロールおよび押圧ロールの1対のロールを用い、その少なくとも一方のロールに平均粒子径が 1.5~150 $\mu\text{m}$ の充填剤を5~50重量%配合したゴムを被覆したロールを用いて押圧することを特徴とする両面つや消しフィルムまたはシートの製造方法。
35	59-027254 S 59. 02. 17 (野村)	63-062241 S 63. 12. 01 彰彦, 藤井	01513242 H01. 08. 24 正彦)	晶出操作によって得られる粉体の固結防止方法	1 晶出操作で粉体を得るに際し、平均分子量3000以下のトリエチレンジアミンポリマーをあらかじめ粉体が溶解している溶液中に添加しておくことを特徴とする粉体の固結防止方法。
36	56-033835 S 56. 03. 11 (諸藤)	63-017765 S 63. 04. 15 正光)	01517434 H01. 09. 07	重炭酸ソーダの製造装置	1 中心部に円錐形状の突起部を有する密閉型の仕切棚にて区割し、各々その内部の断面中心部にガイド筒を設置して反応部を形成するように構成した複数反応段からなり、かつ、各段反応部上部から各々の下段の反応部に、ただし、最下段反応部はスラリー受槽に、生成重炭酸ソーダを含むアンモニアかん水または塩安分離母液を移行させるためのスラリー流出管を、そして最上段反応部を除く各段反応部上部の気相部から各々の上段の反応部下部および最下段の反応部下部に炭酸ガス含有ガスを移行させるためのガス流入管を設置して、各段反応部においてアンモニアかん水または塩安分離母液と炭酸ガスを向流的に接触、反応するようにした重炭酸ソーダの製造装置。
37	56-062576 S 56. 04. 27 (岩本)	63-061979 S 63. 11. 30 英次, 浜田	01517435 H01. 09. 07 基宏)	臭素化キナクリドンの製造法	1 キナクリドンを濃硫酸に溶解させ、得られたキナクリドンの硫酸溶液に臭素を添加してキナクリドンの芳香核に臭素原子を置換させることを特徴とする臭素化キナクリドンの製造法。 2 キナクリドンを濃硫酸に溶解させ、得られるキナクリドン溶液に臭素を添加し、キナクリ



No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>ドンの芳香核に臭素原子を置換し臭素化キナクリドンの硫酸溶液とし、次いでこの硫酸溶液を水またはアルコールで希釈し、微細な結晶を析出させることを特徴とする臭素化キナクリドンの製造法。</p> <p>3 キナクリドンを濃硫酸に溶解させ、臭素を添加してキナクリドンの芳香核に臭素原子を置換し、臭素化キナクリドンの硫酸溶液とし、これに硫酸バリウム、水酸化バリウムまたは塩化バリウムを分散または溶解させ水またはアルコールを混合することを特徴とする臭素化キナクリドンと硫酸バリウムの混晶体の製造法。</p>
38	56-067612 S 56.05.07 (藤本 宮木)	63-065060 S 63.12.14 輝雄, 五十野善信 義行)	01517436 H01.09.07	アミノ酸の分離・精製方法	1 陽イオン交換基を持つ高分子と陰イオン交換基をもつ高分子とイオン交換基を持たない高分子とが直鎖状に結合した分子構造を持つ三元ブロック共重合体からなる複合膜を用いる事を特徴とするアミノ酸の分離・精製方法。
39	56-144605 S 56.09.16 (西崎)	63-067509 S 63.12.26 克己, 森下	01517442 H01.09.07 延男)	接着性樹脂組成物	1 エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物100重量部に対し、ポリビニルブチラールを1~50重量部配合してなる熱溶着型接着剤組成物。
40	58-091594 S 58.05.26 (旭 清水)	63-067804 S 63.12.27 哲也, 鈴木 明彦)	01517457 H01.09.07 祐二)	塩化ビニル系グラフト共重合体の製造方法	1 懸濁安定剤を含有する水性媒体中で、エチレン-酢酸ビニル共重合体の存在下に塩化ビニルまたは、塩化ビニルと、塩化ビニルと共重合しうるモノマーとの混合物を重合させることによって、塩化ビニル系グラフト共重合体を製造する方法において、エチレン-酢酸ビニル共重合体を、あらかじめ塩化ビニルまたは、塩化ビニルと、塩化ビニルと共重合しうるモノマーとの混合物によって膨潤させ、ついで攪拌を開始して膨潤状態のまま前記エチレン-酢酸ビニル共重合体を粉砕した後油溶性ラジカル開始剤を加えて重合を開始させ、その後、エチレン-酢酸ビニル共重合体を溶解させないように前記塩化ビニルまたは、塩化ビニルと塩化ビニルと共重合しうるモノマーとの混合物を連続的または間欠的に添加し重合させることを特徴とする塩化ビニル系グラフト共重合体の製造方法。
41	55-155762 S 55.11.07 (清田 菊地)	62-007217 S 62.02.16 徹, 佐藤 光雄)	01523425 H01.10.12 孝男)	陽イオン交換膜の製法	1 スルホン酸基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体とカルボン酸基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体との混合物のフィルムとカルボン酸基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体のフィルムとをはり合せ、次いでカルボン酸基になりうる基およびスルホン酸基になりうる基を各々カルボン酸基およびスルホン酸基に転換することを特徴とする陽イオン交換膜の製法。
42	56-134843 S 56.08.29 (升島 今井日出夫, 吉田)	01-002213 H01.01.17 努, 林 久信)	01522474 H01.10.12	個体成分の分析法およびその装置	1 固体成分を光音響分光法により分析するにあたり、フィルターを内蔵したルアーハブのフィルター上部に、あらかじめ固体成分を捕集した後、前記ルアーハブのフィルターの試料捕集面側に入光窓ガラスを固着した接続具を嵌着し、かつ他端を検出部に装着して試料セルを形成することにより固体成分を測定することを特徴とする固体成分の分析法。 2 試料セルとこの試料セル中の試料に光を照射する光源と前記試料からの音波を検出する検